

### 性能特点

- 高精度 MEMS 微米加工
- 高性能、全屏蔽、抗干扰微型腔体滤波器
- 硅基片、50Ω 共面波导输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块应用

### 环境参数

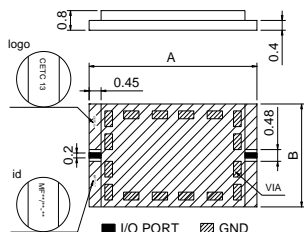
工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最高输入功率	35dBm

### 电特性(T<sub>A</sub>=+25°C)

项目	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率(f <sub>0</sub> )	-	9	-	GHz
通带频率范围	8.6	-	9.4	GHz
带内波动	-	-	1	dB
中心插损	-	-	1.6	dB
回波损耗	15	-	-	dB
带外衰减	≥30@8.1GHz&9.95GHz		-	dB
	≥40@8GHz&10.1GHz		-	dB
	≥60@DC~6GHz		-	dB
	≥50@11~14GHz		-	dB
时延波动	≤1@8.6~9.4GHz		-	ns
线性相位	≤±5@8.6~9.4GHz		-	°

S2P 文件名: SiMF9\_R8-6E3.s2p

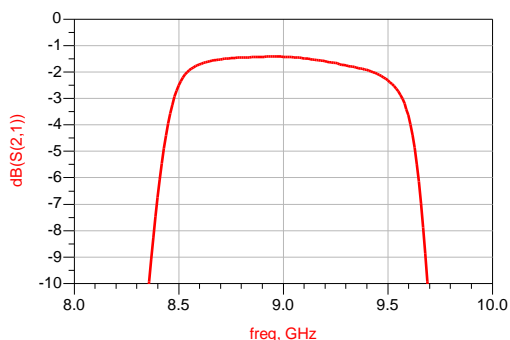
### 外形尺寸



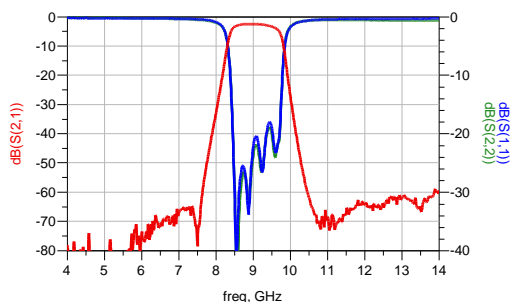
尺寸符号	数值(mm)		
	最小值	公称值	最大值
A	6.9	-	7.0
B	4.1	-	4.2

### 典型测试曲线

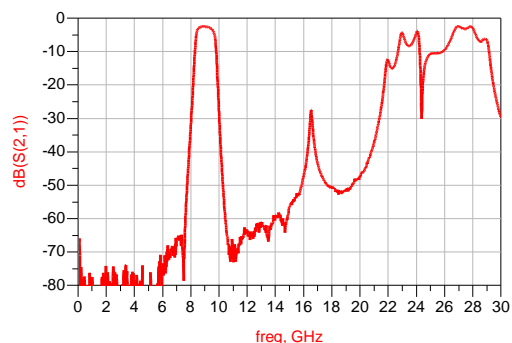
通带损耗 VS 频率(T<sub>A</sub>=25°C)



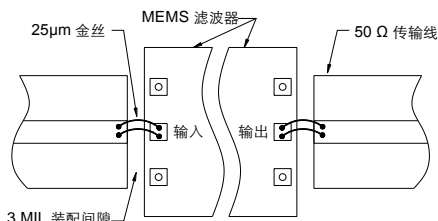
带外抑制 & 回波损耗 VS 频率(T<sub>A</sub>=25°C)



远端抑制 VS 频率(T<sub>A</sub>=25°C)

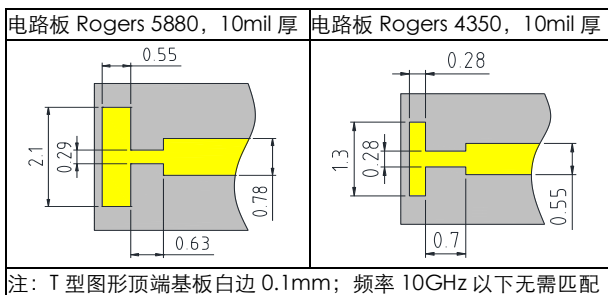


### 建议装配图



### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，两侧距侧壁 0.2mm，表面距上盖 3mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上，载体厚度 ≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配，T 型尺寸如下：



注: T 型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配

5. 有问题请与供货商联系。